



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HB834

对应国外型号
KSB834

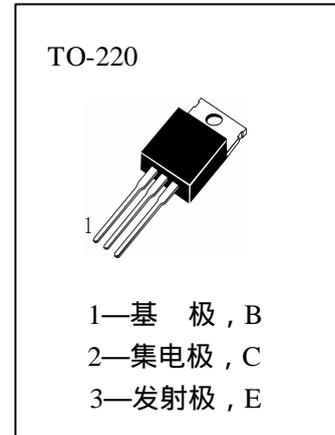
主要用途

低频功率放大，伴音帧输出及电源调整(与 HD880 互补)

极限值 (T_a=25)

T _{stg}	—— 贮存温度.....	-65~150
T _j	—— 结温.....	150
P _C	—— 集电极功率耗散 (T _c =25)	1.5W
P _C	—— 集电极功率耗散 (T _a =25)	30W
V _{CB0}	—— 集电极—基极电压.....	-60V
V _{CEO}	—— 集电极—发射极电压.....	-60V
V _{EBO}	—— 发射极—基极电压.....	-7V
I _C	—— 集电极电流.....	-3A
I _B	—— 基极电流.....	-0.5A

外形图及引脚排列



电参数 (T_a=25)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I _{CB0}	集电极—基极截止电流			-100	μ A	V _{CB} =-60V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	μ A	V _{EB} =-7V, I _C =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-60			V	I _C =-50mA, I _B =0
h _{FE(1)}	直流电流增益	60		200		V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A
h _{FE(2)}	直流电流增益	20				V _{CE} =-5V, I _C =-3A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降		-0.5	-1	V	I _C =-3A, I _B =-0.3A
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压		-0.7	-1	V	V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A
f _T	特征频率		9		MHz	V _{CE} =-5V, I _C =-0.5A
C _{ob}	共基极输出电容		150		pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1.0 MHz
t _{on}	导通时间		0.4		μ s	- I _{B1} =I _{B2} =0.2A, V _{CC} =-30V
t _s	载流子贮存时间		1.7		μ s	
t _f	下降时间		0.5		μ s	

分档及其标志

O	Y
60—120	100—200



特性曲线

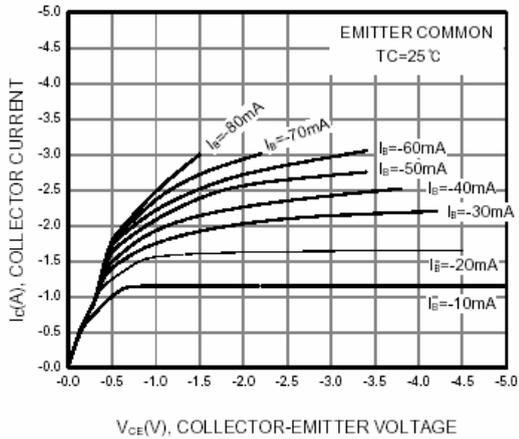


Figure 1. Static Characteristic

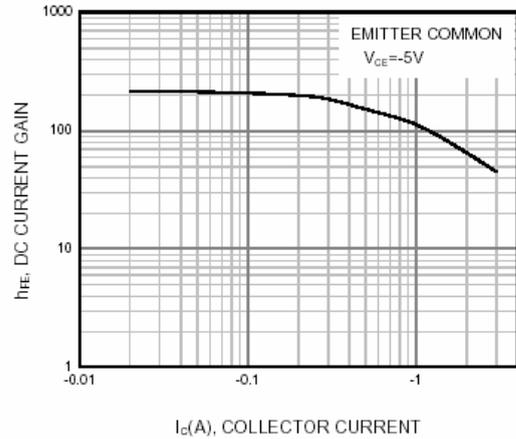


Figure 2. DC current Gain

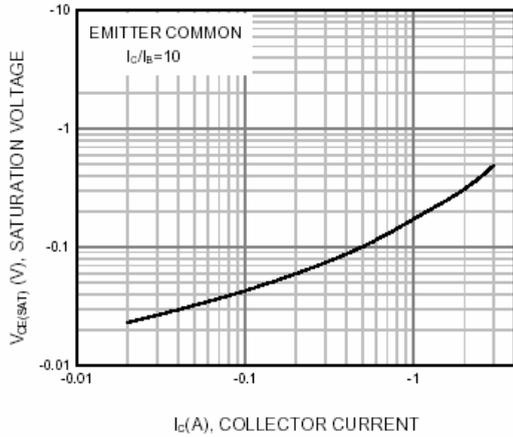


Figure 3. Collector-Emitter Saturation Voltage

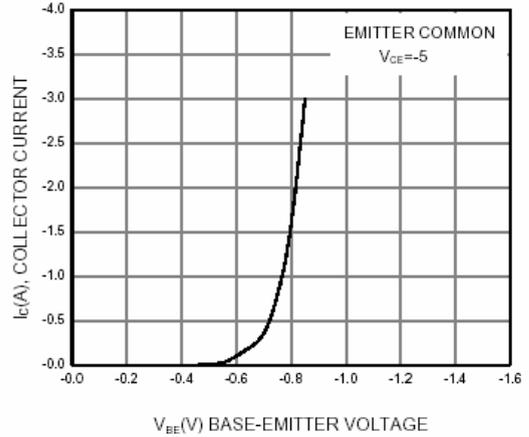


Figure 4. Base-Emitter On Voltage

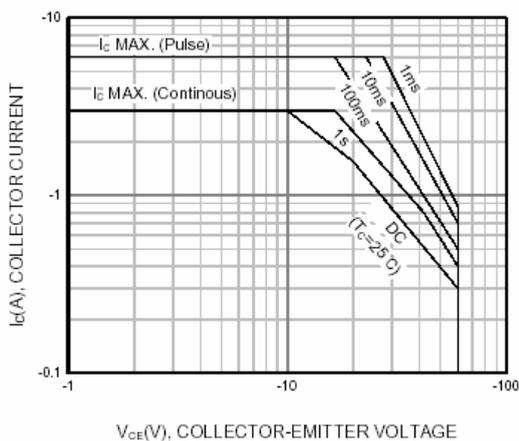


Figure 5. Safe Operating Area

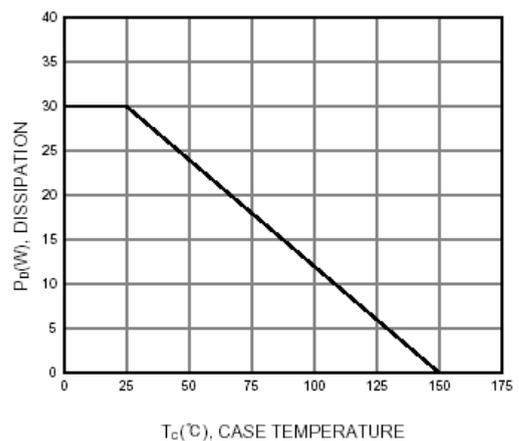


Figure 6. Power Derating